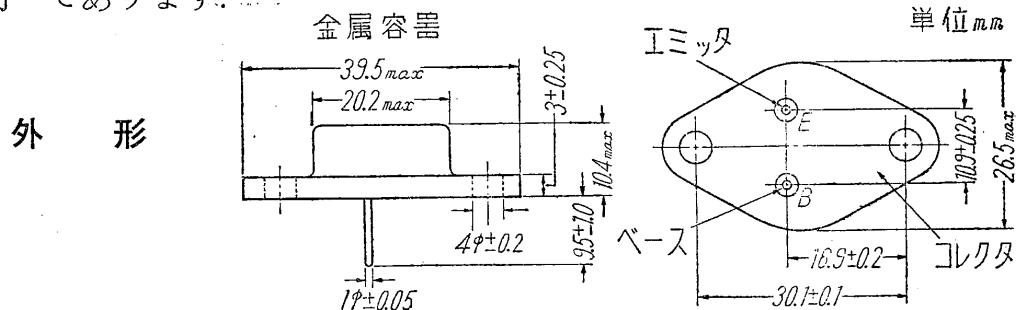


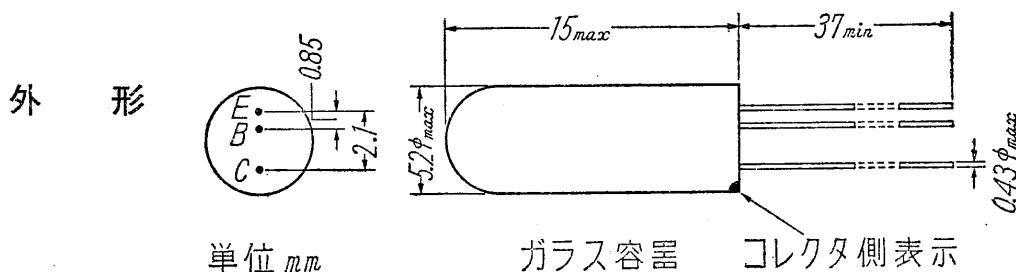
## 2SB70(OC70), 2SB71(OC71), 2SB92(OC72)

2SB118 は完全金属封止の PNP 合金接合型トランジスタで、最大コレクタ・ベース電圧が 15V である以外は 2SB119 の特性と全く同一であります。



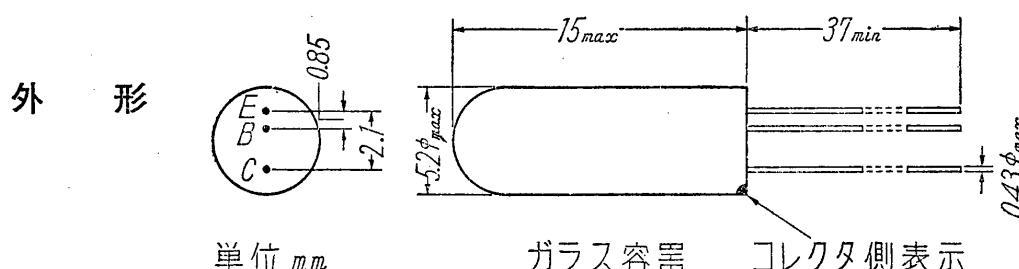
## 2SB70 (OC70) — PNP 合金接合型 ゲルマニウムトランジスタ

2SB70 は完全ガラス封止の PNP 合金型トランジスタで、外型容器および特性は OC70 と全く同一であります。特性は 2SB170 とも全く同一ですから、ご参照下さい。



## 2SB71 (OC71) — PNP 合金接合型 ゲルマニウムトランジスタ

2SB71 は完全ガラス封止の PNP 合金型トランジスタで、外形、容器、および特性は OC71 と全く同一であります。特性は 2SB171 とも全く同一ですから、ご参照下さい。

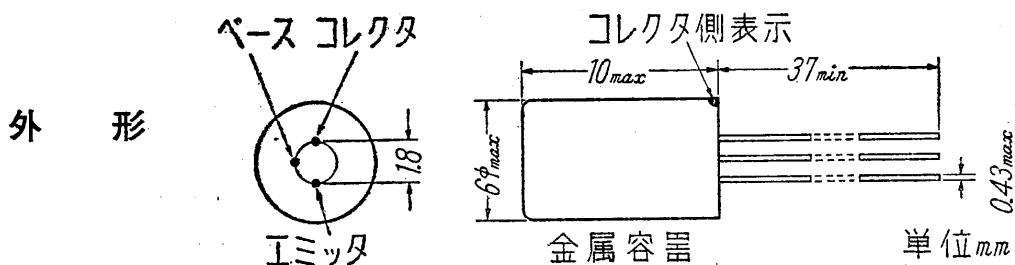


## 2SB92 (OC72) — PNP 合金接合型 ゲルマニウムトランジスタ

2SB92 は完全ガラス封止され、その上に金属容器を被せた PNP 合

# 2SB170 (OC70) — PNP 合金接合型 ゲルマニウム ツランジスタ

**2SB170** は完全金属封止の PNP 合金接合型トランジスタで小電力、低周波用として増幅の場合中程度の利得が得られますので、補聴器の初段などに最適です。またこれ以外に 0.3Mc までの増幅やスイッチング、発振などにも使用できる万能型であります。



## 最大定格

保存温度 $T_{stg}$	.....	-55~85°C
ジャンクション温度 $T_j$	.....	最大 75 °C
直流、交流重畠コレクタ電圧	.....	第 7 図参照
コレクタ・ベース電圧(尖頭値) $-V_{CBM}$	.....	最大 30 V
コレクタ・ベース電圧(平均) $-V_{CBAV}$	.....	最大 30 V
コレクタ電流(尖頭値) $-I_{CM}$	.....	最大 50 mA
コレクタ電流(平均) $-I_{CAV}$	.....	最大 10 mA
コレクタ損失 $P_C$	.....	第 2 図参照
エミッタ電流(尖頭値) $I_{EM}$	.....	最大 55 mA
エミッタ電流(平均) $I_{EAV}$	.....	最大 12 mA
ベース電流(尖頭値) $-I_{BM}$	.....	最大 5 mA
ベース電流(平均) $-I_{BAV}$	.....	最大 2 mA

## 特性 (周囲温度25°Cにおいて)

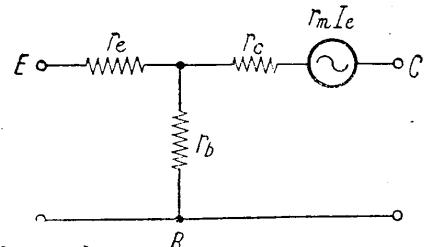
“ $r$ ”パラメータ ( $-V_{CB}=2V$ ,  $-I_c=0.5mA$ ,  $f=1000$  サイクル) 第 1 図参照

エミッタ抵抗 $r_e$	.....	39 Ω
ベース抵抗 $r_b$	.....	1000 Ω
コレクタ抵抗 $r_c$	.....	1.43M Ω
相互抵抗 $r_m$	.....	1.38M Ω

## 共通ベース接続 “h” パラメータ

( $-V_{CB}=2V$ ,  $-I_c=0.5mA$ ,  $f=1000$  サイクル)

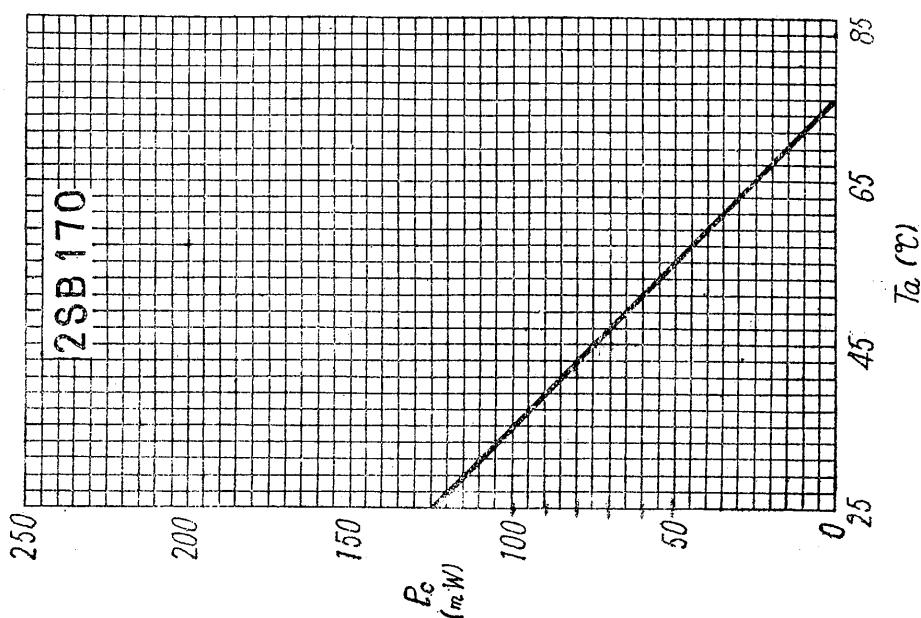
閉路入力インピーダンス  $h_{ib}$  ..... 71 Ω



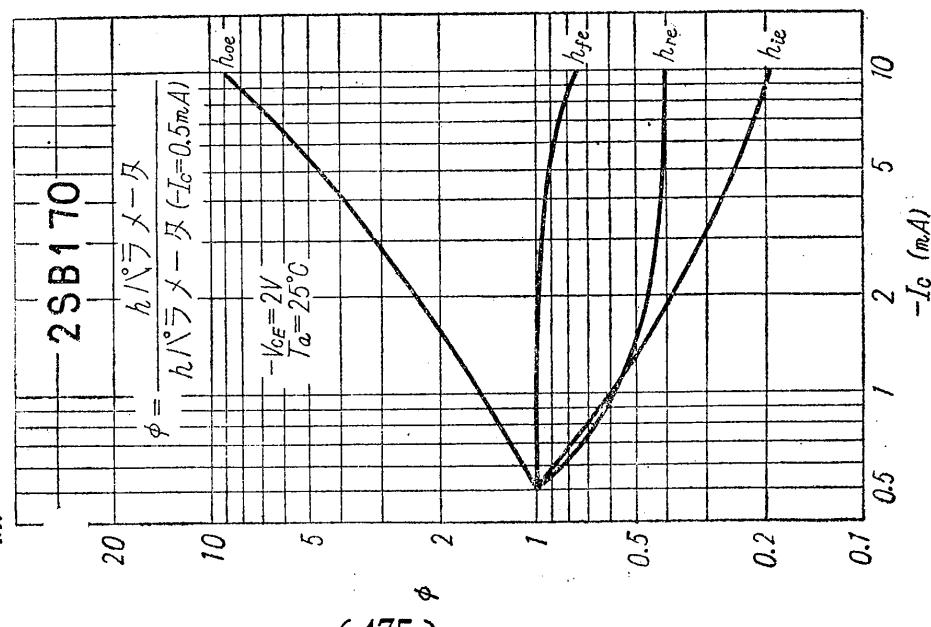
2SB170(OC70)

閉路順方向電流増幅率 $h_{fb}$	0.968
開路出力アドミッタンス $h_{ob}$	0.7 $\mu\Omega$
開路逆方向電圧増幅率 $h_{rb}$	$7 \times 10^{-4}$
共通エミッタ接続 "h" パラメータ ( $-V_{CE}=2V$ , $-I_C=0.5mA$ , $f=1000$ サイクル)	
閉路入力インピーダンス $h_{ie}$	2.2 $k\Omega$
	最小 平均 最大
閉路順方向電流増幅率 $h_{fe}$	20 30 40
開路出力アドミッタンス $h_{oe}$	23 $\mu\Omega$
開路逆方向電圧饋還率 $h_{re}$	$9 \times 10^{-4}$
共通ベース接続	
コレクタ遮断電流 $-I_{CBO}$ ( $-V_{CB}=4.5V$ , $I_E=0$ )	最大 12 $\mu A$
共通エミッタ接続	
コレクタ遮断電流 $-I_{CEO}$ ( $-V_{CE}=4.5V$ , $I_B=0$ )	110 $\mu A$
コレクタ電流 $-I_C$ ( $-V_{CE}=4.5V$ , $-I_B=10\mu A$ )	0.4 mA
コレクタ電流 $-I_C$ ( $-V_{CE}=4.5V$ , $-I_B=250\mu A$ )	10 mA
ベース電圧 $-V_{BE}$ ( $-V_{CE}=4.5V$ , $-I_B=10\mu A$ )	110 mV
ベース電圧 $-V_{BE}$ ( $-V_{CE}=4.5V$ , $-I_B=250\mu A$ )	275 mV
遮断周波数 $f_{ae}$ ( $-V_{CE}=2V$ , $-I_C=0.5mA$ )	15 kc
雑音指数 NF ( $-V_{CE}=2V$ , $-I_C=0.5mA$ , $f=1000$ サイクル, $Z_{in}=500\Omega$ )	10 dB

[第2図] 周囲温度に対する最大  
許容コレクタ損失

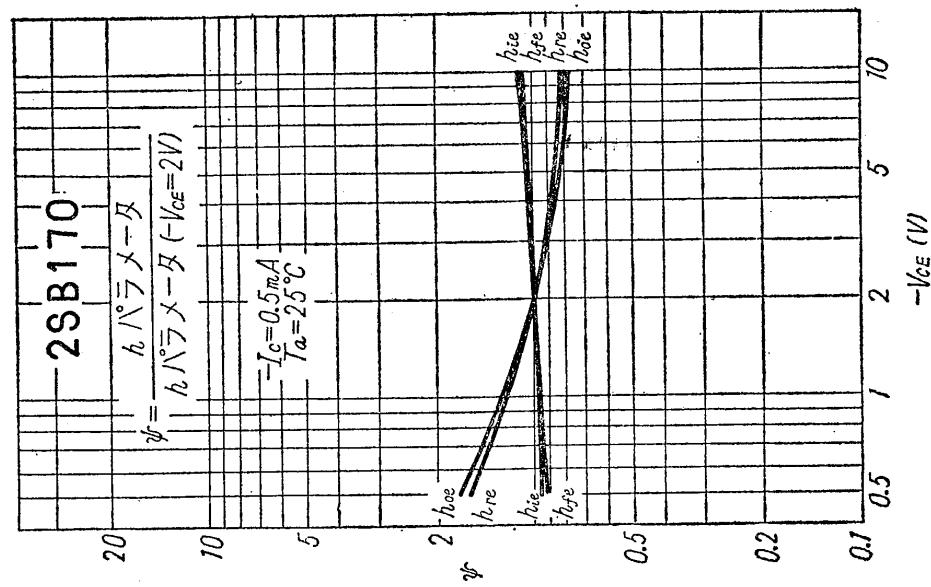


[第 5 図] 共通エミッタ接続コレクタ電流によるパラメータ変換曲線

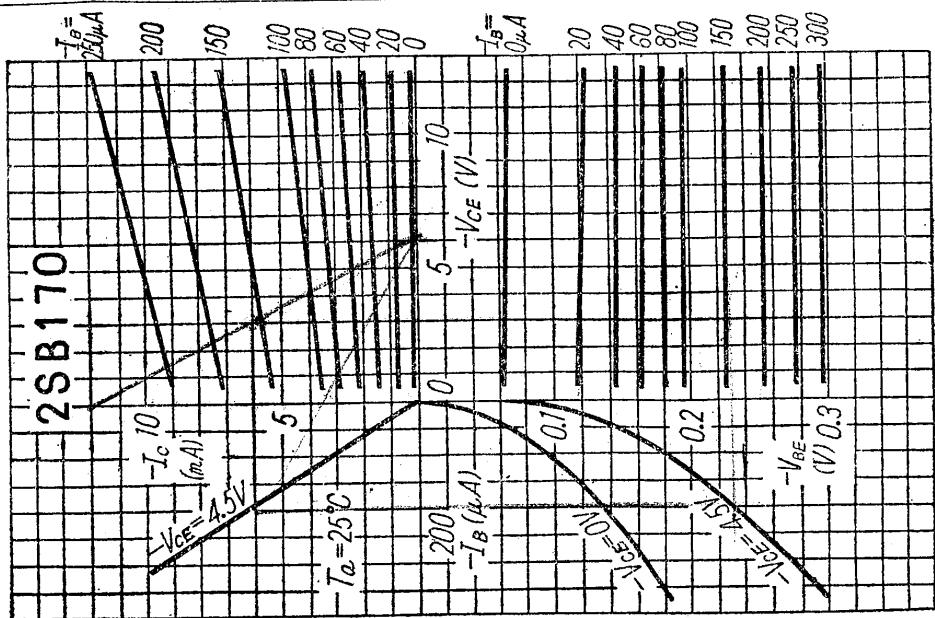


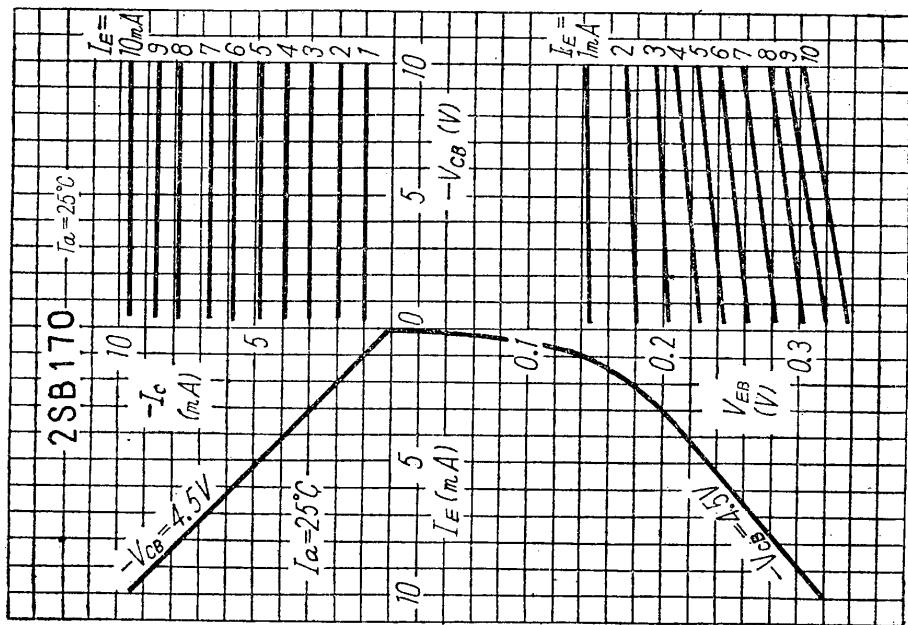
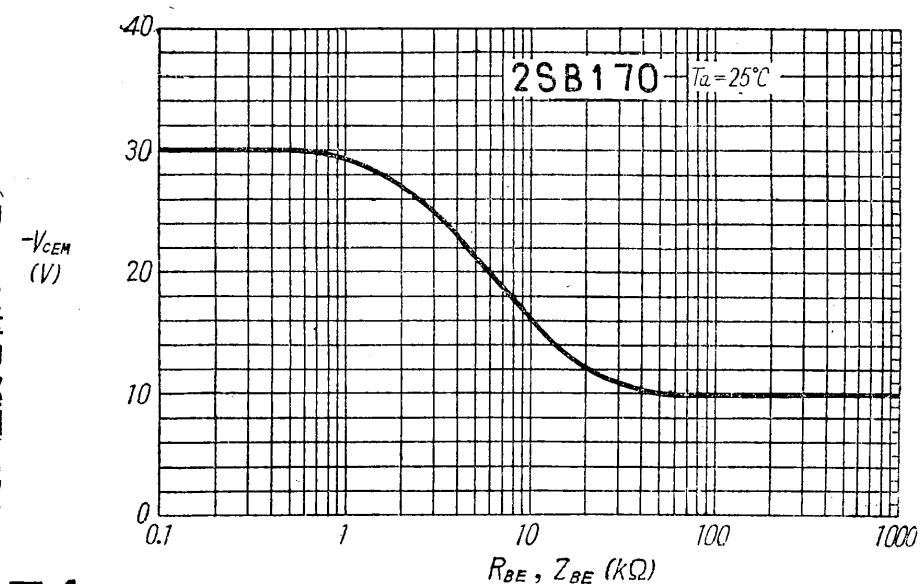
(475)

[第 4 図] 共通エミッタ接続コレクタ電圧による“h”パラメータ変換曲線



[第 3 図] 共通エミッタ接続特性曲線



〔第6図〕共通ベース接続特性  
曲線〔第7図〕ベース・エミッタ間に許される最大電圧  
（ビータ・エミッタを保つこと）  
レジスト・温度を一定に保つこと

**2SB171 (OC71)** — PNP合金接合型 ゲルマニウムトランジスタ

2SB171 は完全金属封止の PNP合金型トランジスタで、小電力低周波用として中程度の利得が得られますので、補聴器などに最適であります。またこれ以外に 0.3Mc までの増幅やスイッチング、発振などに使用できる万能型であります。

